



V1.1

**中科海高**  
HiGaAs Microwave

**HGC140-2**

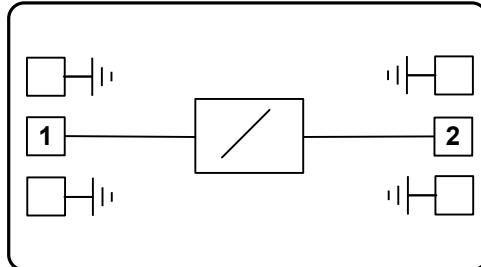
**GaAs MMIC**  
均衡器芯片, 6 - 24 GHz

**6**

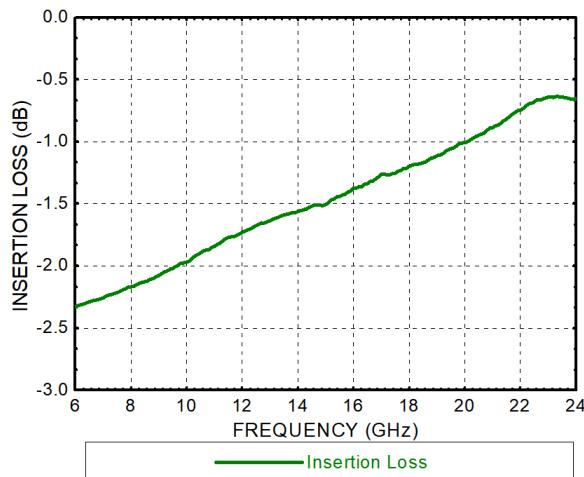
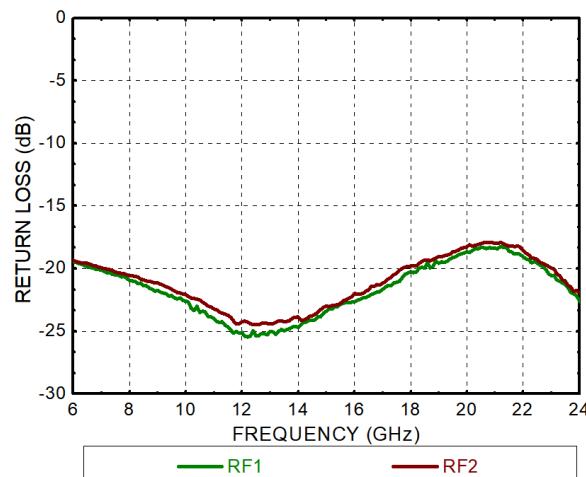
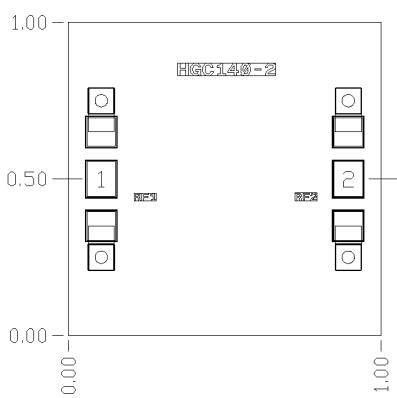
**均衡器**  
|  
**裸芯片**

**主要特点**

频率范围: 6 - 24 GHz  
插入损耗: 0.65 dB @ 24 GHz  
均衡量: 2 dB  
回波损耗: 20 dB  
芯片尺寸:  $1.0 \times 1.0 \times 0.1 \text{ mm}^3$

**功能框图****性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ )**

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	6-24			GHz
插入损耗@24GHz		0.65		dB
均衡量		2		dB
回波损耗		20		dB

**插入损耗****回波损耗****物理参数****焊盘描述**

焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该焊盘是射频输入/输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm, 如果外部射频电压不是 0V, 那么需要外接隔直电容



V1.1

**中科海高**  
HiGaAs Microwave

**HGC140-2**

**GaAs MMIC**  
**均衡器芯片, 6 - 24 GHz**

**6**

**均衡器 - 裸芯片**

### 注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件, 运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100  $\mu\text{m}$
3. 典型键合焊盘尺寸为 120\*100  $\mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化: 金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息: 材质: SiN+PBO; 厚度: 0.5+1.6 $\mu\text{m}$

### 极限参数

1. 射频输入功率: +30 dBm
2. 储存温度: -65 ~ +150  $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度: -55 ~ +85  $^{\circ}\text{C}$